聚乙二醇对氧化钨薄膜结构和电致变色性能的影响

孙喜莲¹ 方燕群²
 (¹南昌大学材料科学与工程学院,江西南昌 330031
 (²中国科学院宁波材料技术与工程研究所,浙江宁波 315201)

摘要 为改善氧化钨薄膜的电致变色性能,通过溶胶-凝胶法钨粉过氧化路线制备了聚乙二醇改性的氧化钨电致 变色薄膜。采用 X 射线衍射仪、光谱椭偏仪、紫外-可见分光光度计和电化学工作站对薄膜的微观结构、光谱调制 能力、着色效率、离子扩散能力、可逆性和响应时间及循环稳定性进行了表征和分析,并研究了聚乙二醇对氧化钨 薄膜结构及电致变色性能的影响。结果表明,聚乙二醇可以使氧化钨薄膜结晶延迟;添加一定量的聚乙二醇可以 得到纳米晶/非晶复合结构薄膜,从而更有利于离子在薄膜中的扩散与迁移;相对于未添加聚乙二醇改性的氧化钨 薄膜,聚乙二醇改性的薄膜具有更宽的光谱调制范围和更高的着色效率,亦表现出良好的可逆性和循环稳定性。

关键词 薄膜;电致变色;氧化钨薄膜;聚乙二醇改性;微结构

doi: 10.3788/AOS201232.1231003 **中图分类**号 O484 文献标识码 A

Effect of PEG-Doping on Microstructure and Electrochromic **Properties of Tungsten-Oxide Thin Films**

Sun Xilian¹ Fang Yangun²

¹ School of Materials Science and Engineering, Nanchang University, Nanchang, Jiangxi 330031, China ² Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo, Zhejiang 315201, China

Abstract In order to improve electrochromic properties of tungsten-oxide (WO_3) thin films, polyethylene glycol (PEG)-doping WO₃ films are prepared by peroxopolytungstic acid sol-gel method. Microstructure, optical and electrochromic properties of the films are investigated by X-ray diffraction, spectral ellipsmetry, ultraviolet-visible spectrophotometer and cyclic voltammetry, respectively. Results show that PEG-doping tungsten-oxide films contain nanocrystalline/amorphous nanostructure, which facilitate ions transport in the films. Compared to pure WO_3 film, the PEG-WO₃ film possesses wider spectral modulation, higher coloring efficiency, good electrochromic reversibility and cyclic stability.

Key words thin films; electrochromism; tungsten-oxide thin film; polyethylene glycol-doping; microstructure OCIS codes 310.1860; 160.2100; 160.4236; 240.0310

引 1

言

相较于晶态 WO3 薄膜,非晶 WO3 薄膜具有更 大的比表面积,更有利于离子在薄膜内的扩散和迁 移,表现出更优异的电致变色性能^[1,2]。作为一种 高性能的电致变色薄膜,其结构、变色性能和变色机 理已被深入研究。但是由于制备方法的制约及非晶 WO₃ 薄膜不稳定的疏松结构的影响,非晶 WO₃ 薄 膜在响应时间、使用寿命和光谱性能上仍有不可忽 视的缺点,使其在实际应用中受到很大的限制。单 纯 WO3 薄膜在性能上已经不能满足要求,因此需 要对其进行改性。研究表明^[3~5],纳米晶 WO₃ 薄膜 相比非晶 WO3 薄膜具有更高的着色效率和稳定 性,展现出了良好的电致变色性能。在溶胶凝胶法 制备过程中,前驱液中加入不同添加剂以及不同的 后处理方式会对 WO₃ 薄膜的微结构和电致变色性 能产生很大影响^[6~12]。Deepa 等^[9]在前驱液中加入

收稿日期: 2012-06-21; 收到修改稿日期: 2012-07-24

基金项目:浙江省自然科学基金(Y12E20040)资助课题。

作者简介:孙喜莲(1978—),女,博士,副教授,主要从事智能变色材料方面的研究。E-mail: xiliansun@163.com

不同质量浓度的草酸,发现适量的草酸可以抑制薄 膜表面裂纹的产生,而且使 WO3 低温结晶,得到镶 嵌纳米晶的非晶薄膜,缩短了电致变色响应时间,提 高了变色性能。因此,在溶胶凝胶法制备 WO3 薄 膜的过程中加入合适的添加剂,并通过合适的后处 理方式制备出纳米晶 WO3 薄膜,可更好地调节其 微观结构,进一步改善 WO3 薄膜的动力学响应、光 学性能以及电化学稳定性能。

聚乙二醇(PEG)作为一种表面活性剂,可以提高氧化钨溶胶的润湿性,使其在导电玻璃表面能够 均匀地铺展,这样可以提高薄膜厚度的均匀性。而 且 PEG 作为一种长链大分子,交错贯穿于溶胶中, 其长链上的亲水基团形成的氢键不但可以使溶胶与 玻璃基底紧密结合,提高了薄膜的粘附性能,而且还 可牢牢地锁住薄膜中的部分水分子,从而提高薄膜 的电致变色性能。聚乙二醇热分解后在薄膜中产生 气孔,使薄膜具有更大的比表面积,促进离子在薄膜 内扩散的动力学过程。因此,本文对添加 PEG 掺杂 改性 WO。薄膜进行了研究。

2 实 验

2.1 薄膜制备

称取 13 g 纯度为 98%的钨粉,分批缓慢加入含 80 mL 双氧水(体积分数为 30%)的三口烧瓶中,并 同时放置在低温水浴槽中。由于双氧水与钨粉的反 应较剧烈,会放出大量的热,因此将温度控制在5℃ 以下。加料完毕后,继续反应 3 h,期间溶液由灰黑 色逐渐转变为白色。将反应产物放入离心机中以 3000 r/min 的转速离心 10 min 以去除瓶底没有完 全反应的少量钨粉。

回流:将滤液加入三口烧瓶中,置于低温水浴槽 中,缓慢加入 80 mL 乙酸酐(质量分数为 98.5%)。 然后,于恒温水浴中搅拌加热到 55 °C,回流 12 h,以 去除过量 H₂O₂。

制备溶胶:将回流得到的乳白色产物以8000 r/min 的转速离心 15 min,除去过量的水和乙酸后,把沉淀物 放入真空干燥箱内烘干得到乙酰化过氧聚钨酸粉末, 干燥温度为 60 °C。取 1 g 粉末溶于 10 mL 无水乙醇 中,在室温下磁力搅拌 30 min 并陈化一段时间,即制得 氧化钨溶胶。同理,将乙酰化过氧聚钨酸粉末溶于乙 醇的同时加入 0.3 g 聚乙二醇 2000,即制得聚乙二醇改 性的氧化钨溶胶。

旋涂成膜:旋涂之前,将氧化锡(FTO)导电玻 璃基片依次放入丙酮、无水乙醇和去离子水中各超 声清洗5 min,再将清洗好的玻璃基片用高纯氮气吹 干备用。旋涂时将制得的氧化钨溶胶在匀胶烘烤一 体机上以 2000 r/min 的转速旋涂 30 s 成膜,然后将 样品在 60 ℃烘干,如此重复多次以达到所需薄膜厚 度。

热处理:将样品放入箱式电阻炉中进行退火处 理,先升温至100℃并保持3h,然后升温至300℃ 退火3h,升温速率为5℃/min,热处理完成后炉内 自然冷却。将未添加和添加PEG改性的WO₃薄膜 样品分别记为WO₃和PEG-WO₃。

2.2 结构分析与性能测试

采用 M2000 型光谱椭偏仪(J. A. Woollam,美 国)测得薄膜的厚度均为 130 nm 左右。用 D8 Advance 型 X 射线衍射仪(XRD)(Bruker AXS,德 国)和 Tecnai F20 型透射电镜(TEM)(FEI,美国) 测定薄膜的微结构;用 Lambda 950 型紫外/可见 光/近红外分光光度仪(Perkin-Elmer,美国)测量 WO₃ 薄膜在原始态、着色态、褪色态的透射光谱;以 制备的 WO₃ 薄膜作为工作电极,Pt 片为对电极,饱 和 Ag/AgCl 电极作参比电极,1 M 的 LiClO₄/PC 溶液为电解质,采用三电极法在 PGSTAT302 型电 化学工作站(欧特莱,荷兰)上测试薄膜的电化学性 能。

3 结果与讨论

3.1 薄膜的结构与形貌

PEG 掺杂前后两种 WO₃ 薄膜的 XRD 谱图如 图 1 所示。由图 1 可知,纯 WO₃ 薄膜的 XRD 谱图 中在 $2\theta = 23.2^{\circ}, 23.6^{\circ}, 24.4^{\circ}$ 处出现了三个很强的 衍射峰,分别对应单斜相的(002)、(020)和(200)面, 表明 该薄膜样品已 经形成良好的结晶状态;而



图 1 纯 WO3 薄膜和 PEG-WO3 薄膜的 XRD 谱图 Fig. 1 XRD patterns for pure WO3 film and PEG-WO3 film

PEG-WO。薄膜的 XRD 谱图上出现了三个强度都 很弱衍射峰,表明其结晶现象存在但不够显著,可能 是一种纳米晶/非晶复合结构。以上实验结果表明, PEG 的添加对 WO。薄膜能够起到延迟结晶和细化 晶粒的作用。

图 2 为 PEG 掺杂前后 WO₃ 薄膜的选区电子衍 射照片。从图 2(a)可知,该薄膜样品的电子衍射图 呈现单晶衍射斑点,说明纯 WO₃ 薄膜结晶良好,且 具有单晶属性;从图 2(b)可如, PEG-WO。薄膜的 电子衍射图呈现一系列规则的同心衍射环,这说明 该薄膜由多晶构成,一方面由于晶粒之间存在晶面 无序态,取向随机,出现了源于无序结构的明亮大晕 环;另一方面由于纳米晶粒内部结晶度较好,又出现 了源于长程有序结构的明暗相间衍射环,且晶粒细 小引起衍射环的变化。与前面的 XRD 结果相结 合,共同证明这是一种纳米晶/非晶的复合结构。



图 2 (a)纯 WO₃ 薄膜与(b)PEG-WO₃ 薄膜的 TEM 谱图 Fig. 2 TEM micrographs of (a) pure WO₃ film and (b) PEG-WO₃ film

图 3 为 PEG 改性前后 WO。薄膜的扫描电镜 (SEM)图。由图 3 可知,纯 WO。薄膜较为致密,均 匀性稍差,表面有裂纹;添加 PEG 改性后,薄膜较为 疏松多孔。这一方面由于 PEG 作为一种表面活性 剂,可以减小胶粒的尺寸,使表面较为疏松;另一方 面热处理过程中 PEG 分解产生气孔。薄膜的相对 密度 P 定义为薄膜的密度与块体的密度之比,其与 材料的光学折射率 n 有关,它们之间的联系可表示 为^[13]

$$P = \Big(rac{n_{
m f}^2 - 1}{n_{
m f}^2 + 1}\Big)\Big(rac{n_{
m b}^2 + 1}{n_{
m b}^2 - 1}\Big),$$
 (1)

式中 n_i 、 n_b 分别为某一材料薄膜与块体在550 nm 处的光学折射率,其中 n_b =2.5。采用椭偏仪测得 WO₃ 薄膜和 PEG-WO₃ 薄膜在550 nm 处的折射率 分别为2.18和2.01,根据上式计算得到两种薄膜 的相对密度分别为0.904和0.831,说明纯WO₃ 薄 膜较为致密,而 PEG-WO₃ 薄膜则较为疏松多孔。 这进一步证实有机添加剂 PEG 的加入对WO₃ 薄膜 的显微结构和微观形貌有调节作用,起到了一定的 造孔作用,使薄膜晶粒纳米化,提高了薄膜的比表面 积,从而进一步改善薄膜的离子传输性能。



图 3 (a)纯 WO3 薄膜与(b) PEG-WO3 薄膜的 SEM 图

Fig. 3 SEM micrographs of (a) pure WO_3 film and (b) PEG-WO₃ film

3.2 薄膜的电化学性能

图 4 为纯 WO₃ 薄膜和 PEG-WO₃ 薄膜的循环

伏安曲线。由图 4 可知,纯 WO₃ 薄膜的循环伏安曲 线中有明显的阴极峰,表明它的结构为晶态结构,而 PEG-WO。薄膜的循环伏安曲线中则没有明显的阴极峰,主要呈现出非晶特征,与上述 XRD、TEM 的结果相吻合,表明这是一种纳米晶/非晶的复合结构。在相同极化电压范围内,PEG-WO。薄膜的循环曲线包围的面积比纯 WO。薄膜要大,即电荷注入量要多。另外,前者的阳极峰峰值电流密度也比较大,表明该薄膜具有更高的电荷存储能力。这是因为 PEG-WO。薄膜呈多孔型纳米晶/非晶复合结构,Li⁺离子在薄膜中迁移/扩散的势垒较低,离子注入和抽取更容易。



图 4 纯 WO₃ 薄膜与 PEG-WO₃ 薄膜的循环伏安曲线 Fig. 4 Cyclic volt-ampere characteristics of pure WO₃ film and PEG-WO₃ film

在扩散控制的电致变色反应中,循环伏安曲线 中阳极峰的峰值电流密度与离子在薄膜中的扩散系 数相关,它们之间关系为^[11]

 $i_p = 2.72 \times 10^5 \times n^{3/2} D^{1/2} C_0 v^{1/2}$, (2) 式中 i_p 为阳极峰的峰值电流密度, n 为氧化还原反应 电子转移数(n = 1), C₀ 为氧化物薄膜中离子达到饱 和时的摩尔浓度(C₀ = 1 mol/L), D 为离子在薄膜中 的扩散系数, v 为电位扫描速度(v = 20 mV/s)。根据 上式计算得到纯 WO₃ 薄膜和 PEG-WO₃ 薄膜的扩散 系数分别为 6.8×10⁻¹² cm²/s 和 5.9×10⁻¹¹ cm²/s, 因此,相较于纯 WO₃ 薄膜, PEG-WO₃ 薄膜的扩散系 数呈现出将近一个数量级的提高。以上分析结果说 明, PEG 的添加对 WO₃ 薄膜的结构和性能有显著 影响。

图 5 为纯 WO₃ 薄膜和 PEG-WO₃ 薄膜的电荷 密度随时间变化的关系曲线。由图 5 可知,在施加 相同电压的情况下,PEG-WO₃ 薄膜注入和抽出的 电荷量都明显增大,这归因于其多孔的纳米晶/非晶 复合结构。且根据可逆性公式 K(K=Q_{out}/Q_{in})计 算得知,纯 WO₃ 薄膜和 PEG-WO₃ 薄膜的可逆参数 K分别为 0.64 和 0.95。因此,添加 PEG 后,薄膜 的可逆性大大增加;其着/退色响应时间也有明显变 化,其中退色时间的变化较大,由 16 s 下降为 3 s。 这从动力学的角度进一步说明 PEG 的添加使 Li⁺ 离子在 WO₃ 薄膜中的注入/抽出更加容易和迅速。 随着 Li⁺离子的注入,薄膜的电阻率急剧下降,注入 量越多,电阻越小,离子注入/抽出越容易^[12]。多孔 型纳米晶/非晶复合结构 WO₃ 薄膜能够提供更多 更容易到达的离子扩散通道,因此其电荷容量更高, 响应更加迅速。



图 5 纯 WO₃ 薄膜与 PEG-WO₃ 薄膜的电荷 密度-时间曲线

Fig. 5 Chronoamperometric response of pure WO_3 film and PEG- WO_3 film

3.3 薄膜的电致变色性能

图 6 为纯 WO₃ 薄膜和 PEG-WO₃ 薄膜在着色态和退色态的透射率曲线。由图 6 可知,在着色状态,PEG-WO₃ 薄膜在可见光区具有更低的透射率,说明着色效果更好;在退色状态,可见区波长范围内薄膜的透射率可达到 80%以上。相对于纯 WO₃ 薄膜,PEG-WO₃ 薄膜的光学调制幅度有明显提高,且 其峰位向短波方向移动,表现在可见光区具有最大 光学调制幅度,可达 40%。这是因为 PEG-WO₃ 薄 膜呈现多孔型纳米晶/非晶复合结构,晶粒细化,由 于量子尺寸效应会导致峰位向短波方向移动,相应 的光谱调制峰位也向短波方向移动。

着色效率是指在某一波长下,单位面积电致变 色材料注入单位电荷后所引起的光密度变化,单位 为 cm²/C,其计算公式为

$$\eta = \frac{\Delta D_{\rm O}}{Q} = \frac{\lg T_{\rm b}/T_{\rm c}}{Q}, \qquad (3)$$

式中 ΔD_0 为注入电荷前后光学密度的变化,Q 为注入的电荷密度,单位为 C/cm²,T_b和 T_c 分别为退色时的透射率与着色时的透射率。通过(3)式可计算得到纯 WO₃ 薄膜和 PEG-WO₃ 薄膜在可见光区的



图 6 纯 WO₃ 薄膜与 PEG-WO₃ 薄膜的着色/褪色态透射率 T_c、T_b 和光谱调制 ΔT(300 nm < λ < 2000 nm)。 (a) 纯 WO₃ 薄膜; (b) PEG-WO₃ 薄膜

Fig. 6 Transmission spectra of pure WO₃ film and PEG-WO₃ film in their colored and bleached states and the corresponding transmission modulation (300 nm $\leq \lambda \leq$ 2000 nm). (a) Pure WO₃ film; (b) PEG-WO₃ film

着色效率 η 如图 7 所示。由图 7 可知,添加 PEG 之 后,WO₃ 薄膜的着色效率比未添加 PEG 制备的 WO₃ 薄膜有明显提高,甚至能达到40 cm²/C。说明 添加 PEG 后,制备得到的 WO₃ 薄膜所呈现的纳米 晶/非晶复合结构具有独特的结构优势,能大大改善 薄膜的着色效率。



图 7 纯 WO₃ 薄膜与 PEG-WO₃ 薄膜的着色效率 Fig. 7 Coloration efficiency of pure WO₃ film and PEG-WO₃ film

由以上实验结果可知,在溶胶中添加少量的 PEG可以改善WO。薄膜的结构和电致变色性能。 PEG热分解后,在薄膜中产生的气孔的孔径和数量 增加,使薄膜具有更大的比表面积,可以有效地调节 薄膜的结构,有利于Li⁺离子的注入和抽取,因此可 以有效改善WO。薄膜的电致变色性能,其光学调 制幅度、着色效率、可逆性和响应时间等电致变色性 能均十分优异。另外,图 8 为其在 1 M LiClO₄/PC 电解液中反复循环 500 次的稳定性测试。由图 8 可 知,薄膜在前 100 次循环过程中性能略有下降,但 200 次循环后曲线趋于稳定,显示出良好的循环稳 定性。



图 8 纯 WO₃ 薄膜与 PEG-WO₃ 薄膜的循环伏安稳定性 Fig. 8 Cyclic voltammetric stability of pure WO₃ film and PEG-WO₃ film

4 结 论

采用溶胶-凝胶法制备了未改性和 PEG 改性的 WO₃ 薄膜,并对比分析了两种薄膜样品的微结构和 电致变色性能。结果表明,PEG 改性的 WO₃ 薄膜 是一种纳米晶/非晶的复合结构,薄膜较为疏松多 孔,因而使其具有更高的电荷存储能力、更大的离子 扩散系数、更好的离子注入/抽出可逆性和更小的着 色/退色响应时间,并具有良好的光谱调制性能和着 色效率以及循环稳定性。这是因为 PEG 热分解后, 在薄膜中产生的气孔的孔径和数量增加,使薄膜具 有更大的比表面积,可以有效地调节薄膜的微结构, 有利于 Li⁺ 离子的注入和抽取,因此有效改善了 WO₃ 薄膜的电致变色性能。

参考文献

 A. Subrahmanyam, A. Karuppasamy. Optical and electrochromic properties of oxygen sputtered tungsten oxide (WO₃) thin films [J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2007, 91(4): 266~274

- 2 M. Deepa, T. K. Saxena, D. P. Singh *et al.*. Spin coated versus dip coated electrochromic tungsten oxide films: structure, morphology, optical and electrochemical properties [J]. *Electrochimica Acta*, 2006, **51**(10): 1974~1989
- 3 Liang Zongcun, Shen Hui. Preparation and research current situation of WO₃ nano-film [J]. Materials Review, 2000, 14(3): 41~43
 - 梁宗存,沈 辉.纳米 WO3 薄膜的制备方法及其研究现状[J]. 材料导报,2000,14(3):41~43
- 4 A. D. Paola, F. D. Quarto, C. Sunseri. Electrochromism in anodically formed tungsten oxide films [J]. J. Electrochemical Society, 1978, 125(8): 1344~1978
- 5 Xu Minhua, Su Lianyong, Xiao Zhongdang *et al.*. Electrochromism and optic-electric chemical properties of tungsten oxide films by electric deposition [J]. *Electron Devices and Materials*, 1998, **17**(1): 17~19
- 徐敏华,苏连永,肖忠党等.电沉积三氧化钨薄膜电致变色及其 光电化学性能[J].电子元件与材料,1998,**17**(1):17~19
- 6 J. M. Wang, E. Khoo, P. S. Lee *et al.*. Synthesis, assembly, and electrochromic properties of uniform crystalline WO₃ nanorods [J]. J. Physical Chemistry C, 2008, **112** (37): 14306~14312
- 7 Y. Djaoued, S. Priya, S. Balaji. Low temperature synthesis of nanocrystalline WO₃ films by sol-gel process [J]. J. Non-Crystalline Solid, 2008, **354**(37): 673~679

- 8 D. J. Taylor, J. P. Cronin, L. F. Allard *et al.*. Microstructure of laser-fired, sol-gel-derived tungsten oxide films [J]. *Chemistry* of Materials, 1996, 8(7): 1396~1401
- 9 M. Deepa, R. Sharma, A. Basu *et al.*. Effect of oxalic acid dihydrate on optical and electrochemical properties of sol-gel derived amorphous electrochromic WO₃ films [J]. *Electrochimica Acta*, 2005, **50**: 3545~3555
- 10 X. L. Sun, H. T. Cao, Z. M. Liu *et al.*. Influence of annealing temperature on microstructure and optical properties of sol-gel derived tungsten oxide films [J]. *Appl. Sur. Sci.*, 2009, 255(20): 8629~8633
- 11 K. Karuppasamy, A. Subrahmanyam. Studies on the correlation between electrochromic colouration and the relative density of tungsten trioxide (WO_{3-x}) thin films prepared by electron beam evaporation [J]. J. Phys. D: Appl. Phys., 2009, 42: 095301
- 12 Li Zaike. Preparation and Electrochromic Properties of WO₃-MoO₃ Films on Flexible Substrate by Sol-Gel Deposition [D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2007. 67~75

李再柯. 柔性衬底 WO₃-MoO₃ 电致变色薄膜溶胶-凝胶制备及性能研究[D]. 长沙:国防科技大学,2007. 67~75

13 X. L. Sun, Z. M. Liu, H. T. Cao. Effects of film density on electrochromic tungsten oxide thin films deposited by reactive dcpulsed magnetron sputtering [J]. J. Alloys and Compounds, 2010, 504S: S418~S421

栏目编辑:韩 峰